

SF 816, SF 817, SF 818, SF 819 pnp SF 826, SF 827, SF 828, SF 829 npn

Silizium-Hochfrequenztransistoren für Breitbandverstärker und mittelschnelle Schalter.

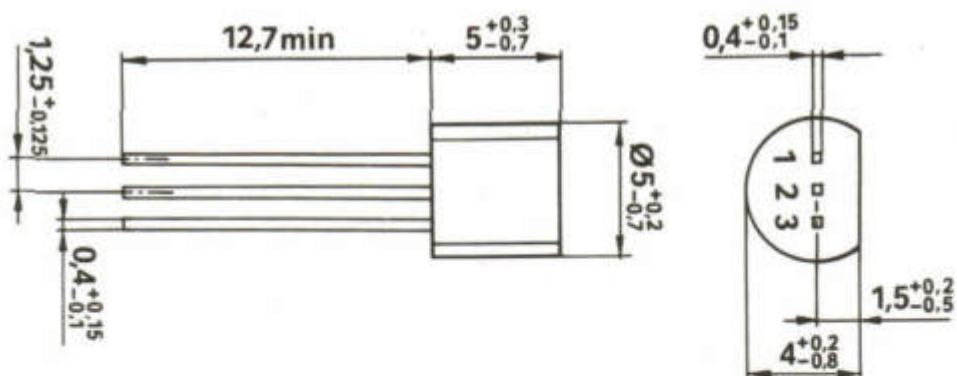
Technische Daten

Bauform: 81

Masse: ≤ 1 g

Gehäuse: 3-poliges SOT-54-Plastgehäuse

Anschlußbelegung:



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich:

	SF 816, 817, 818, 819				SF 826, 827, 828, 829				
U_{CBO}	-20	-30	-60	-80	33	66	100	120	V
U_{CEO}	-20	-30	-60	-80	20	30	60	80	V
I_C		-500				500			mA
I_{CM}		-1000				1000			mA
I_B		250				-250			mA
$P_{tot}^*)$ (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$)		735				735			mW
ϑ_j		150				150			$^\circ\text{C}$
$R_{thja}^*)$		170				170			K/W
ϑ_a		-40 ... +125				-40 ... +125			$^\circ\text{C}$

*) $P_{tot} = 735 \text{ mW}$ und $R_{thja} = 170 \text{ K/W}$ gilt, wenn der Transistor mit max. 5 mm langen Anschlußdrähten auf einer Leiterplatte mit einer Kupferfläche von $A_{Cu} = 0,1 \text{ cm}^2$ für den Kollektoranschluß angeordnet ist.

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$):

$/I_{\text{CBO}}/$ SF 816 (bei $-U_{\text{CB}} = 20\text{ V}$) :)
SF 817 (bei $-U_{\text{CB}} = 30\text{ V}$) :)
SF 818 (bei $-U_{\text{CB}} = 60\text{ V}$) :) $\leq 100\text{ nA}$
SF 819 (bei $-U_{\text{CB}} = 80\text{ V}$) :)

SF 826 (bei $U_{\text{CB}} = 33\text{ V}$) :)
SF 827 (bei $U_{\text{CB}} = 66\text{ V}$) :) $\leq 100\text{ nA}$
SF 828 (bei $U_{\text{CB}} = 100\text{ V}$) :)
SF 829 (bei $U_{\text{CB}} = 100\text{ V}$) : $\leq 60\text{ nA}$
(bei $U_{\text{CB}} = 120\text{ V}$) : $\leq 1000\text{ nA}$

$/I_{\text{EBO}}/$ SF 816 ... SF 819 (bei $-U_{\text{EB}} = 5\text{ V}$) :) $\leq 1\text{ }\mu\text{A}$
SF 826 ... SF 829 (bei $-U_{\text{EB}} = 7\text{ V}$) :)

$/U_{(\text{BR})\text{CEO}}/$ (bei $/I_{\text{C}}/ = 10\text{ mA}$)
SF 816, SF 826 : $\geq 20\text{ V}$
SF 817, SF 827 : $\geq 30\text{ V}$
SF 818, SF 828 : $\geq 60\text{ V}$
SF 819, SF 829 : $\geq 80\text{ V}$

$/U_{\text{CEsat}}/$ (bei $/I_{\text{C}}/ = 150\text{ mA}$, $/I_{\text{B}}/ = 15\text{ mA}$) : $\leq 0,5\text{ V}$

$h_{21\text{E}}$ (bei $/U_{\text{CE}}/ = 2\text{ V}$, $/I_{\text{C}}/ = 50\text{ mA}$)

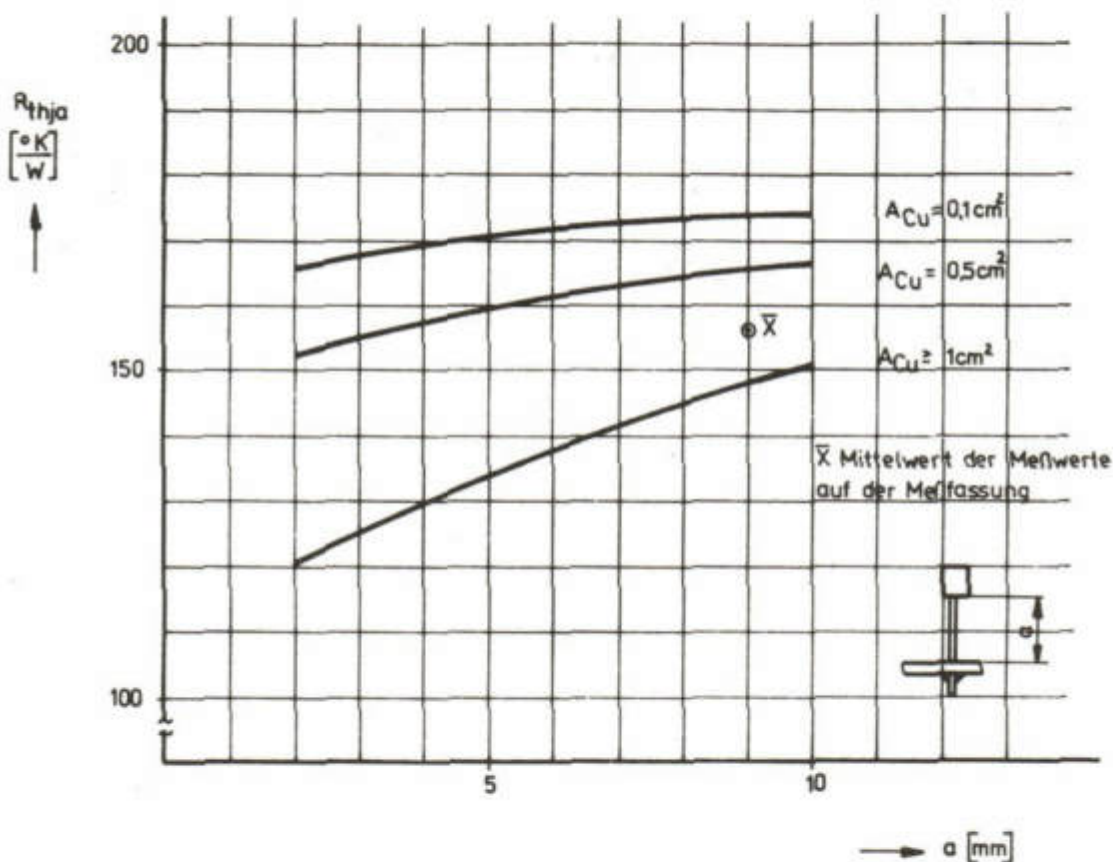
Selektionsklasse

A : 18 ... 35
B : 28 ... 71
C : 56 ... 140
D : 112 ... 280
E : 224 ... 560

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$):

f_{T} (bei $/U_{\text{CE}}/ = 10\text{ V}$, $/I_{\text{C}}/ = 10\text{ mA}$, $f = 15\text{ MHz}$) : $\geq 60\text{ MHz}$

Wärmewiderstand der SOT-54-Gehäuse (SF 826, SF 816) in Abhängigkeit des Abstandes Gehäuse-Platine (a) und der Kupferfläche am Kollektoranschluß (A_{Cu}).



Aq 05/021/86

RFT



veb halbleiterwerk frankfurt/oder
im veb kombinat mikroelektronik
DDR 1200 Frankfurt/Oder – Telefon 4 60

**elektronik
export-import**

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie